Документ подписан простой электронной подписы МИНИСТ ЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректор по безопасности и общим вопросам

Дата подписания: 09.07.2023 20:52:24 Уникальный программный ключ:

d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

ФГАОУ ВО НИТУ "МИСиС"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе бакалавриата

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образованию

Волков А.А.

11.03.04

31.08.2022

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Институт новых материалов и нанотехнологий

Квалификация: Форма обучения: Очная форма Срок получения образования: 4 г. Год начала подготовки 2022

(по учебному плану)

Учебный год <u>2022-2023</u>

Образовательный стандарт

(CYOC) <u>95 o.B. ot 02.04.2015</u>

Код	Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты
40	СКВОЗНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
40.058	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

+	Основной	Типы задач профессиональной деятельности
+	+	научно-исследовательская
+	-	производственно-технологический

Календарный учебный график

Mec	Τ	Cein	ябрі	ь	S.	0	тябр	рь	2		Hos	брь			Дека	брь		+	Я	map	%		Фе	вра	пь	_		Ma	рт			An	рель	Τ,	\Box		Mai	ă	Т		Июн	ь	Π.	Ţ	M	αль	П	7	- 1	Apry	cT	٦
4ucaa	1.7	8 . 34	15 - 23	22 - 38	29.	6 - 32	33 - 39	20 - 36	27.	3 - 9	30 - 36	17 - 23	24 - 30	1 - 7	8 - 14		22 - 28	29 -	5 - 33	12 - 38	39 - 25	36	2.8	9 - 15	16 - 22	- 23 -	2 - 8	9 - 15	16 - 22	23 - 29	30	6 - 32	13 - 79	9	- 22	4 - 30			•	•	7	13 - 21		٦.	6 - 32	• [8.9	N		30.30	١,	24 - 33
Нед	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33 3	И 3	35	36	37	38	39	10	41 4	12 4	13 4	14 4	15 4	16	17	48	49 !	50 !	51 5	2
1	L	Γ	Г		Г														Э	Э	э	K	K											Т	\Box	П						э :	Э.	Э	K	K	K	K	К	K	K	К
11																			Э	э	э	к	к																			э :	э	э	У	У	y y y y K	к	к	к	к	К
Ш	L																		Э	Э	э	K	K																			э :	э і	п	n I	n I	п	K	K	K	K	К
IV																			Э	Э	Э	K	K													э	Пд	ПД	Д	Д	Д	ц	Д	Д	K	K	К	K	K	K	K	K

Сводные данные

			Курс 1			Курс 2			Курс 3			Курс 4		Итого
		Сем. 1	Cen. 2	Boero	Сем. 3	Сен. 4	Boero	Cen. 5	Сем. 6	Boero	Cen. 7	Cen. 8	Boero	итого
	Теоретическое обучение и практики	18	18	36	18	18	36	18	18	36	18	12	30	138
Э	Экзаменационные сессии	3	3	6	3	3	6	3	2	5	3	1	4	21
У	Учебная практика					2 4/6	2 4/6							2 4/6
П	Производственная практика								4	4				4
Пд	Преддипломная практика											2	2	2
Д	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы											6	6	6
К	Каникулы	2	8	10	2	5 2/6	7 2/6	2	5	7	2	8	10	34 2/6
(не в	олжительность обучения ключая нерабочие праздничные дни никулы)	60.	пее 39 н	ед.	60.	nee 39 ii	ед.	60.	лее 39 н	ед.	60.	лее 39 н	ед.	
Ито	го	23	29	52	23	29	52	23	29	52	23	29	52	208
Сту	дентов													
Груг	nn		·	·										

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код направления 11.03.04, год начала подготовки 2022

Индекс	к/ ча Наименование	Цели освоения дисциплины (модуля)	Формируемые компетенции
51	Дисциплины (модули)		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
51. O	Обязательная часть		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-4; ПК-5
Б1.О.01	Б1. История		УК-5; УК-11
Б1.О.02	Б1. Философия		УК-3; УК-5; УК-11
Б1.О.03	Б1. Введение в научно-исследо	ОВ	УК-6
Б1.О.04	Б1. Инженерная и компьютерн	ая	УК-1; УК-2; ОПК-4
Б1.О.05	Б1. Иностранный язык		УК-3; УК-4
Б1.О.06	Б1. Физическая культура и спо	рт	УК-7
Б1.О.07	Б1. Математика		УК-1; УК-2; ОПК-1
Б1.О.08	Б1. Математическая статистик		УК-2; ОПК-2; ОПК-3
Б1.О.09	Б1. Методы математической ф	из	УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-4
Б1.О.10	Б1. Физика		УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2
Б1.О.11	Б1. Химия		УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2
Б1.О.12	Б1. Органическая химия		УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2
Б1.О.13	Б1. Информатика		УК-1; ОПК-3; ОПК-4
Б1.О.14	Б1. Экономика		УК-10
Б1.О.15	Б1. Производственный менедж	м	УК-3; УК-10; ОПК-5
Б1.О.16	Б1. Физическая химия		УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2
Б1.О.17	Б1. Электротехника		УК-1; ОПК-4; ПК-5
Б1.О.18	Б1. Безопасность жизнедеятел	ьн	УК-2; УК-8; УК-9; ПК-1
Б1.В	Часть, формируемая участниками образователь		УК-1; УК-2; УК-7; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б1.В.01	Б1. Элективные курсы по физи	че	УК-7
Б1.В.02	Б1. Основы квантовой механин		УК-1; ПК-4
Б1.В.03	Б1. Практическая кристаллогр	эф	УК-2; ОПК-1; ПК-4
Б1.В.04	Б1. Электроника		ОПК-2; ПК-5
Б1.В.05	Б1. Физические свойства крист	a	УК-1; ОПК-1; ПК-5
Б1.В.06	Б1. Статистическая физика		УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-4
Б1.В.07	Б1. Физика конденсированного	0 C	УК-1; УК-2; ОПК-2; ПК-3; ПК-4
Б1.В.08	Б1. Материаловедение полупр		УК-1; УК-2; ОПК-1; ОПК-2; ПК-2
Б1.В.09	Б1. Технология материалов эл		УК-1; ОПК-4; ПК-1; ПК-4; ПК-5
Б1.В.10	Б1. Физика диэлектриков		УК-1; ОПК-1; ПК-5
Б1.В.11	Б1. Инженерная математика		
Б1.В.12	Б1. Основы проектирования электронной компонентной	16	УК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-2; ПК-4
Б1.В.13	Б1. Методы исследования материалов и структур эле	кт	УК-1; ОПК-2; ПК-2
Б1.В.ДВ.0	1 Б1. Дисциплины (модули) по в	ыб	УК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-4
Б1.В.Д	Д Б1. Метрология, стандартизаці и технические измерения в		УК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-4
Б1.В.Д	Д Б1. Метрология, стандартизаці и технические измерения в		УК-2; ОПК-2; ПК-1; ПК-4

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код направления 11.03.04, год начала подготовки 2022

Индекс к/ ч	Наименование	Цели освоения дисциплины (модуля)	Формируемые компетенции
Б1.В.ДВ.02 Б1.	Дисциплины (модули) по выб		ОПК-1; ПК-3; ПК-4
Б1.В.Д Б1.	Биполярные полупроводнико		ОПК-1; ПК-3; ПК-4
Б1.В.Д Б1.	Физика магнитных явлений		ОПК-1; ПК-3; ПК-4
Б1.В.Д Б1.	Квантовая и оптическая элек		ОПК-1; ПК-3; ПК-4
	Дисциплины (модули) по выб		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Полевые полупроводниковые		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Материаловедение ферритов и родственных магнитных си		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Ионно-плазменная обработк		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-5
Б1.В.ДВ.04 Б1.	Дисциплины (модули) по выб		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Компьютерные технологии проектирования процессов н		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Физико-математические модели процессов наноэлект		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Основы технологии электронной компонентной б		ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4; ОПК-5
Б1.В.ДВ.05 Б1.	Дисциплины (модули) по выб		УК-1; ОПК-1; ПК-3
Б1.В.Д Б1.	Физика импульсного отжига		УК-1; ОПК-1; ПК-3
Б1.В.Д Б1.	Приемники оптического излу		УК-1; ОПК-1; ПК-3
	Физические основы электрон		УК-1; ОПК-1; ПК-3
	Дисциплины (модули) по выб		УК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Наноэлектроника полупроводниковых приборо		УК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Дефекты в оптоэлектронных полупроводниковых прибора		УК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Функциональная наноэлектр		УК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Полупроводниковая наноэле		УК-2; ОПК-4; ПК-5
Б1.В.ДВ.07 Б1.	Дисциплины (модули) по выб		ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Основы технологии электрон		ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Моделирование технологических процессов п		ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Математические модели технологических процессов п		ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5
Б1.В.ДВ.08 Б1.	Дисциплины (модули) по выб		УК-2; ОПК-2; ПК-3
	Вакуумная и плазменная эле		УК-2; ОПК-2; ПК-3
	Квантоворазмерные структур		УК-2; ОПК-2; ПК-3
Б1.В.Д Б1.	Технология производства ферритовых материалов и ра		УК-2; ОПК-2; ПК-3
Б1.В.Д Б1.	Процессы вакуумной и плазм		УК-2; ОПК-2; ПК-3
	Дисциплины (модули) по выб		УК-2; ОПК-1; ПК-5
	Приборы квантовой и оптиче		УК-2; ОПК-1; ПК-5
+	Светоизлучающие полупров		УК-2; ОПК-1; ПК-5
	Магнитные измерения		УК-2; ОПК-1; ПК-5
Б1.В.Д Б1.	Оборудование производства ферритовых материалов и ра		УК-2; ОПК-1; ПК-5
Б1.В.ДВ.10 Б1.	Дисциплины (модули) по выб		УК-2; ОПК-2; ПК-2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ Учебный план бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код направления 11.03.04, год начала подготовки 2022

Индекс	K	/ ча Наименование	Цели освоения дисциплины (модуля)	Формируемые компетенции
Б1.І	в.д в	Основы радиационной стойкости изделий электрон		УК-2; ОПК-2; ПК-2
Б1.І	в.д в	51. Элементы и устройства магн		УК-2; ОПК-2; ПК-2
Б1.І	в.д Е	1. Физика взаимодействия частиц и излучений с вещест		УК-2; ОПК-2; ПК-2
Б2		Практика		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б2.О		Обязательная часть		
Б2.B		Часть, формируемая участниками образовательны		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б2.В.Д Е	B.01 E	2. Учебная практика		УК-2; УК-4; ОПК-3; ПК-3
Б2.І	в.д Е	52. Учебная практика по получению первичных профе		УК-2; УК-4; ОПК-3; ПК-3
Б2.І	в.д Е	Vuodung projetura po		УК-2; УК-4; ОПК-3; ПК-3
Б2.В.ДЕ	B.02 E	2. Производственная практика		УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5
Б2.І	в.д в	Производственная практика по получению профессиональных умений и		УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5
Б2.І	в.д в	Производственная практика по получению профессиональных умений и		УК-2; УК-3; ОПК-2; ОПК-5; ПК-2; ПК-4; ПК-5
Б2.В.ДЕ	B.03	2. Преддипломная практика		УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3
Б2.І	в.д Е	52. Преддипломная практика для выполнения выпускной к		УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3
Б2.І	в.д Е	52. Преддипломная практика для выполнения выпускной к		УК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1; ПК-3
Б2.В.ДЕ	B.04 E	2. Научно-исследовательская р		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б2.І	в.д в	2. Научно-исследовательская р		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б2.І	в.д в	2. Научно-исследовательская р		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б3		Государственная итоговая аттестация		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б3. <u>Д</u> В.01	E	33 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б 3.ДВ.0	01.0 E	33 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
Б 3.ДВ.(01.0	Полготориз и процелуре		УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5
ФТД		Факультативные дисциплины		ПК-4; ПК-5
ФТД.01	c	ОТ Оформление результатов на		ПК-4
ФТД.02	C	РТ Нормы и правила оформлени		ПК-5
К.М		Комплексные модули		
K.M.01	ŀ	С.М Модуль 1		

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОФ.СТАНДАРТОВ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ Учебный план бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код направления 11.03.04, год начала подготовки 2022

Индекс	Содержание
ип задач проф. деятельности:	производственно-технологический
ПК-1	Способность контролировать подготовку и техническое оснащение рабочих мест на участках производства изделий микроэлектроники
40.058	инженер-технолог по производству изделий микроэлектроники
Α	Контроль технологических процессов производства изделий микроэлектроники
A/01.5	Контроль подготовки и технического оснащения рабочих мест на участках производства изделий микроэлектроники
тд.1	Проверка уровня технического оснащения рабочих мест на производстве изделий микроэлектроники на соответствие нормам технической документации
тд.6	Подготовка документов для выполнения работ по специальной оценке условий труда
У.3	Определять потребность в технологическом, контрольно-измерительном и вспомогательном оборудовании на рабочих местах
3н.3	Технологический процесс производства изделий микроэлектроники
3н.4	Основное технологическое оборудование, контрольно-измерительное и вспомогательное оборудование производства изделий микроэлектроники и принципы его работы
ПК-2	Способность контролировать соблюдение режимов технологических операций, процессов производства изделий микроэлектроники
40.058	ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
А	Контроль технологических процессов производства изделий микроэлектроники
A/02.5	Контроль соблюдения режимов технологических операций процессов производства изделий микроэлектроники
ТД.4	Выявление причин брака в изготовлении изделий микроэлектроники
ТД.5	Статистический анализ пригодности и воспроизводимости технологических процессов производства изделий микроэлектроники
У.1	Оперативно решать технологические проблемы в процессе производства изделий микроэлектроники
У.6	Использовать контрольно-измерительное оборудование для контроля режимов технологических операций процессов производства изделий микроэлектроники
У.8	Использовать стандартные компьютерные программы для обработки статистических данных
3н.4	Виды дефектов при изготовлении изделий микроэлектроники
3н.5	Технологические факторы, вызывающие погрешности изготовления изделий микроэлектроники
Зн.6	Методы уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления изделий микроэлектроники

КУРС	1 Учебный план (бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код направ	вления 11.	.03.04, г	од нача	ала под	готовки :	2022																								
							Семестр	1								Семе	стр 2								Итого з	а кур	5					
					A	кадемі	ических ч	асов						A	Академі	ически	их часов						Α	кадем	ически	к часс	В		3.e.	, !	ıl	
Nº	Индекс	Наименование	Контроль	Bcero	Кон такт.	Лек	Лаб Г	p CI	Р Конт оль	P	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	CP Koi	нтро ль	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контро ль	Всего		Каф.	Семестр
итс	ГО (с факультатив	вами)		1134						29			1134						31	21		2268							60	42		
итс	ГО по ОП (без фан	сультативов)	1	1134						29	21		1134	1					31	21		2268							60	42	ĺ	
		ОП, факультативы (в период ТО)		54									53									53.5									ĺ	
\4.15	ELIA CILIA EDVOICA	ОП, факультативы (в период экз. сес.)		54									60									57								ı İ	ĺ	
	БНАЯ НАГРУЗКА, д.час/нед)	Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		29.4									25.5									27.5								Į į	ĺ	
	. , .,	Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)	ļ	29.4									25.5									27.5								Į į	ĺ	
		Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)																													—	
ди	сциплины (мо	дули)		1134	529	136	85 3	08 44	3 162	2 29	TO: 18 9: 3		1134	459	119	102	238 4	95 1	.80 31	ТО: 18 Э: 3		2268	988	255	187	546	938	342	60	TO: 36 Э: 6		
1	Б1.О.01	История	3a	108	34	17	1	7 74	4	3											3a	108	34	17		17	74		3		19	1
2	Б1.O.02	Философия										За	108	34	17		17	'4	3		3a	108	34	17		17	74		3		19	2
3	Б1.O.03	Введение в научно-исследовательскую деятельность										3a	216	34			34 1	82	6		За	216	34			34	182		6			2
4	Б1.0.04	Инженерная и компьютерная графика	3a	108	34		3	4 74	4	3											3a	108	34			34	74		3		39	1
5	Б1.O.05	Иностранный язык	3aO	180	85			5 9	5	5		3aO	180	85			85 9	95	5		3aO(2)	360	170			170	190		10		18	12345
-		Физическая культура и спорт	3a	36	36			6		1											3a	36	36			36	Ш		1	l l	20	13
7		Математика	Эк	288	170	68	1)2 28	8 90	8		Эк	216	102	_			_	90 6		Эк(2)	504	272	_		170	52	180	14	l l	16	123
8		Физика										Эк	180	102	-	34	-	_	36 5		Эк	180	_	-	34	34	42	36	5		17	234
_		Химия	3aO	144	85			7 59		4		Эк	108	51	17	_			54 3		Эк ЗаО	252	136	_	68	17	62	54	7		15	12
10		Информатика	Эк	180	85	17	51 1	7 2	3 72	5		3a	108	51	17	34		57	3	-	Эк За	288	136	34	85	17	80	72	8		36	12
	B1.B.U1	Элективные курсы по физической культуре и спорту		90				90	0				18					8				108					108				20	123456
ФО	РМЫ КОНТРОЛЯ					Эк(2	2) 3a(3) 3	aO(2)							Эк	(3) 3a	(3) 3aO									Эк(5)	3a(6) 3a	0(3)				
ПР	ктики	(План)																														
гос	УДАРСТВЕННАЯ	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (План)																														
KAI	ІИКУЛЫ										2									8										10		

КАНИКУЛЫ

КУРС 2 Учебный план	ı бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код напраг	1	.05.0 1, 1	од пач	unu mor			-																									
			_			Семе										Семес	<u> </u>									Итого за						-	
					Академі Т	ически	1X 4aco	В		-					Академ Т	ически)	х часо	В						A	кадем	ических	часо	В		3.e.			
№ Индекс	Наименование	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контр оль	з.е.	Недель	Контроль	Bcero	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контр оль	3.e.	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контро ль	Всего	Недель	Каф.	Семестр
ИТОГО (с факультати	вами)		1062							27	24		1206							33	22.4/6		2268							60	44.416		
ИТОГО по ОП (без фа	акультативов)	1	1062							27	21		1206							33	23 4/6		2268							60	44 4/6		
	ОП, факультативы (в период ТО)		53										53										53										
	ОП, факультативы (в период экз. сес.)		36										36										36										
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)	Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		27.5										24.6										26.1										
(акад. час/пед)	Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		27.5										24.6										26.1										
	Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)																																
дисциплины (мо	одули)		1062	495	153	68	274	459	108	27	TO: 18 Э: 3		1062	442	136	85	221	512	108	29	TO: 18 9: 3		2124	937	289	153	495	971	216	56	TO: 36 3: 6		
1 51.0.05	Иностранный язык	3aO	180	85			85	95		5		3aO	180	85			85	95		5		3aO(2)	360	170			170	190		10		18	12345
2 51.0.06	Физическая культура и спорт	3a	36	36			36			1												3a	36	36			36			1		20	13
3 51.0.07	Математика	Эк	144	68	34		34	40	36	4												Эк	144	68	34		34	40	36	4		16	123
4 F1.O.08	Математическая статистика и анализ данных											3aO	108	34	17		17	74		3		3aO	108	34	17		17	74		3		16	4
5 51.0.09	Методы математической физики											3a	108	51	17		34	57		3		3a	108	51	17		34	57		3		16	4
6 51.0.10	Физика	Эк	180	102	34	34	34	42	36	5		Эк	144	85	34	34	17	23	36	4		Эк(2)	324	187	68	68	51	65	72	9		17	234
7 51.0.12	Органическая химия	3a	108	51	17	17	17	57		3												3a	108	51	17	17	17	57		3		15	3
8 51.0.14	Экономика	3a	108	68	34		34	40		3												3a	108	68	34		34	40		3		34	3
9 51.0.16	Физическая химия	Эк	216	85	34	17	34	95	36	6		Эк	108	51	17	17	17	21	36	3		Эк(2)	324	136	51	\rightarrow	51	116	72	9		29	34
10 51.0.17	Электротехника											3aO	108	34	17	17		74		3		3aO	108	34	17	17		74		3		171	4
11 51.B.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту		90					90					18					18					108					108				20	123456
12 51.B.02	Основы квантовой механики											3aO	144	51	34		17	93		4		3aO	144	51	34		17	93		4		26	4
13 51.B.03	Практическая кристаллография											Эк	144	51		17	34	57	36	4		Эк	144	51		17	34	57	36	4		23	4
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ	A				Эн	к(3) За	(3) 3aC)							Эн	(3) 3a 3	3aO(4))								Э	к(6) 3	3a(4) 3	BaO(5)				
ПРАКТИКИ	(План)												144					144		4	2 2/3		144					144		4	2 2/3		
Б2.В.ДВ.01.01(У)	Учебная практика по получению первичных профессиональных умений											3a	144					144		4	2 2/3	3a	144					144		4	2 2/3	25	4
<i>Б2.В.ДВ.01.02(У)</i>	52.В.ДВ.01.02(У) Учебная практика по получению первичны. профессиональных умений											3a	144					144		4	2 2/3	3a	144					144		4	2 2/3	27	4
ГОСУДАРСТВЕННАЯ	ОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИ! (План)																																
	()																											_					

5 2/6

7 2/6

КУРС 3 Учебный пла	н бакалавриата '11.03.04-БЭН-22.plx', код напра	вления 1	1.03.04	год на	чала п	одгото	вки 20	122																									
						Семе	стр 5									Семес	тр 6									Итого	за кур	С					
					кадемі	ически	іх часо	В							Академ	ически	х часо	В						Α	Академ	иическ	их час	ОВ		з.е.			
№ Индекс	Наименование	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контр оль	3.e.	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контр оль	3.e.	Недель	Контроль	Всего	Кон такт.	Лек	Лаб	Пр	СР	Контр оль	Всего	Недель	Каф.	Семестр
ИТОГО (с факультати	ивами)		1026		_					27			1246							33			2272							60			
ИТОГО по ОП (без фа	,		1026							27	21		1246	İ						33	24		2272							60	45		
	ОП, факультативы (в период ТО)		51										51.3										51.2										
	ОП, факультативы (в период экз. сес.)		36										54	ĺ									45										
УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА, (акад.час/нед)	Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		23.7										20.8	ĺ									22.3										
(акад.час/нед)	Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		23.7										20.8	ĺ									22.3										
	Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)													1																			
дисциплины (мо	ОДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ		1026	425	153	51	221	493	108	27	TO: 18 Э: 3		1030	374	136	119	119	548	108	27	TO: 18 Э: 2		2056	799	289	170	340	1041	216	54	TO: 36 9: 5		
1 51.0.05	Иностранный язык	Эк	108	51			51	21	36	3												Эк	108	51			51	21	36	3		18	12345
2 51.0.18	Безопасность жизнедеятельности	3a	108	34	17		17	74		3												3a	108	34	17		17	74		3]	14	5
3 61.B.01	Элективные курсы по физической культуре и спорту		54					54					58					58					112					112				20	123456
4 61.B.04	Электроника	3aO	108	51	17	17	17	57		3												3aO	108	51	17	17	17	57		3]	25	5
5 61.B.05	Физические свойства кристаллов	3aO	108	51	17		34	57		3												3aO	108	51	17		34	57		3]	23	5
6 51.B.06	Статистическая физика	3aO	108	51	17		34	57		3												3aO	108	51	17		34	57		3		26	5
7 61.B.07	Физика конденсированного состояния	Эк	144	68	34	17	17	40	36	4		Эк КР	180	85	34	17	34	59	36	5		Эк(2) КР	324	153	68	34	51	99	72	9]	25	56
8 51.B.08	Материаловедение полупроводников и диэлектриков	3aO	144	68	34		34	76		4		3aO	108	51	17	34		57		3		3aO(2)	252	119	51	34	34	133		7		23	56
9 61.8.09	Технология материалов электронной техники											Эк	180	68	17	17	34	76	36	5		Эк	180	68	17	17	34	76	36	5		27	6
10 51.B.10	Физика диэлектриков											3aO	108	51	17	17	17	57		3		3aO	108	51	17	17	17	57		3		23	6
11 51.B.11	Инженерная математика											3aO	108	51	17	17	17	57		3		3aO	108	51	17	17	17	57		3		27	6
12 Б1.В.ДВ.01.01	Метрология, стандартизация и технические измерения в полупроводниковой электронике	Эк	144	51	17	17	17	57	36	4												Эк	144	51	17	17	17	57	36	4		25	5
13 <i>Б1.В.ДВ.01.02</i>	Метрология, стандартизация и технические измерения в магнитоэлектронике	Эк	144	51	17	17	17	57	36	4												Эк	144	51	17	17	17	57	36	4		27	5
14 Б1.В.ДВ.02.01	Биполярные полупроводниковые приборы											Эк	180	68	34	17	17	76	36	5		Эк	180	68	34	17	17	76	36	5]	25	6
15 Б1.В.ДВ.02.02	Физика магнитных явлений											Эк	180	68	17	17	34	76	36	5		Эк	180	68	17	17	34	76	36	5		27	6
16 Б1.В.ДВ.02.03	Квантовая и оптическая электроника											Эк	180	68	17	17	34	76	36	5		Эк	180	68	17	17	34	76	36	5		27	6
17 Б2.В.ДВ.04.01(Н)	Научно-исследовательская работа											3aO	108					108		3		3aO	108					108		3		25	678
18 Б2.В.ДВ.04.02(Н)	Научно-исследовательская работа											3aO	108					108		3		3aO	108					108		3		27	678
ФОРМЫ КОНТРОЛ	Я				Эк	(3) 3a	3aO(4)							Эк	(3) 3a(O(4) KP	•									Эк(6)	3a 3aO(8) KP				
ПРАКТИКИ	(План)												216					216		6	4		216					216		6	4		
Б2.В.ДВ.02.01(П)	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности											3a	216					216		6	4	3a	216					216		6	4	25	6
Б2.В.ДВ.02.02(П)	Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности											3a	216					216		6	4	3a	216					216		6	4	27	6
государственна	Я ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (План)																																

каникулы

Г	Т							Семес	тр 7								C	Семестр 8	8							ı	Итого	за курс	;					
						F	Академ	ически	х часов							Ак	адеми	ческих ча	асов						Α	кадемі	ически	х часо	В		3.e.			
١	o N	1ндекс	Наименование	Контроль		Кон		n		ор К	онтр	з.е.	Недель	Контроль		Кон		D. 6		Контр 3	.e. H	Іедель	Контроль		Кон				00	Контр		Недель	Каф.	Семестр
					Bcero	такт.	Лек	Лаб	Пр	CP	оль				Bcero	такт.	Jlek	Лаб Пр	CP	оль				Boero	такт.	Лек	Лаб	Пр	CP	оль	Bcero			
И	ГОГС	Э (с факультатив	 вами)		1152			ш				32			1152					3	32			2304							64			
		О по ОП (без фан			1080							30	21		1080						30	21		2160							60	42		
			ОП, факультативы (в период ТО)		51										49.5									50.3										
yı	ІЕБН	НАЯ НАГРУЗКА,	ОП, факультативы (в период экз. сес.)		54 21.8										54 17									54 19.4										
(a	кад.	час/нед)	Ауд. нагр. (ОП - элект. курсы по физ.к.) Конт. раб. (ОП - элект. курсы по физ.к.)		21.8	1									17									19.4										
			Ауд. нагр. (элект. курсы по физ.к.)																															
Д	исц	циплины (мод	ДУЛИ) И РАССРЕД. ПРАКТИКИ		1080	391	170	102	119	527 :	162	30	TO: 18 9: 3		648	204	84	36 84	4 390	54 1	18 T	ГО: 12 Э: 1		1728	595	254	138	203	917	216	48	TO: 30 9: 4		
	Б	1.0.15	Производственный менеджмент	3aO	108	51	17	17	17	57		3							-			-	3aO	108	51	17	17	17	57	\neg	3	•	31	7
	5	i1.B.12	Основы проектирования электронной компонентной базы. Пакеты прикладных	Эк	180	68	34	17	17	58	54	5										[Эк	180	68	34	17	17	58	54	5		25	7
Ľ.			программ			-	٠.				٠.								_			ļ								<u> </u>				
1	Б	1.B.13	Методы исследования материалов и структур электроники	3aO	108	51	17	17	17	57		3											3aO	108	51	17	17	17	57		3		23	7
-	Б	1.В.ДВ.03.01	Полевые полупроводниковые приборы	Эк КР	180	68	34	17	17	58	54	5							\perp			ļ	Эк КР	180	68	34	17	17	58	54	5		25	7
!	5	51.В.ДВ.03.02	Материаловедение ферритов и родственных магнитных систем	Эк КР	180	68	17	17	34	58	54	5							\perp				Эк КР	180	68	17	17	34	58	54	5		27	7
-	Б	51.В.ДВ.03.03	Ионно-плазменная обработка материалов	Эк КР	180	68	17	17	34	58	54	5										ļ	Эк КР	180	68	17	17	34	58	54	5		27	7
	Б	1.В.ДВ.04.01	Компьютерные технологии проектирования	Эк	144	51	17	17	17	39	54	4											Эк	144	51	17	17	17	39	54	4		25	7
\vdash	+		процессов наноэлектроники <i>Физико-математические модели процессов</i>			_	<u> </u>	\vdash		+							\vdash		+			ŀ							+					
-	5	51.В.ДВ.04.02	наноэлектроники	Эк	144	51	17	17	17	39	54	4							_			ļ	Эк	144	51	17	17	17	39	54	4		25	7
	Б.	51.В.ДВ.04.03	Основы технологии электронной компонентной базы. Технология тонких	Эк	144	51	17	17	17	39	54	4											Эк	144	51	17	17	17	39	54	4		27	7
-) F	1.В.ДВ.05.01	пленок Физика импульсного отжига	3aO	108	51	17	17	17	57	\dashv	3					\vdash		+			ŀ	3aO	108	51	17	17	17	57		3		25	7
1	_	51.В.ДВ.05.02	Приемники оптического излучения	3aO	108	51	17	17	_	57		3										ŀ	3aO	108	51	17	17	17	57		3		25	7
1	2 5	51.В.ДВ.05.03	Физические основы электроники	3aO	108	51	17	17	_	57		3										į	3aO	108	51	17	17	17	57		3		27	7
1	3 Б	1.В.ДВ.06.01	Наноэлектроника полупроводниковых приборов и устройств	3aO	144	51	34		17	93		4											3aO	144	51	34		17	93		4		25	7
Ι.		-1 0 00 00 00	Дефекты в оптоэлектронных	0-0			24		47	00		_											0-0	444		24		47	00				٥٢	7
L	4 6	51.В.ДВ.06.02	полупроводниковых приборах на широкозонных материалах	3aO	144	51	34		17	93		4											3aO	144	51	34		17	93		4		25	7
1	-	51.В.ДВ.06.03	Функциональная наноэлектроника	3aO	144	51	34			93		4										[3aO	144	51	34		17	93		4		27	7
	\top	51.В.ДВ.06.04	Полупроводниковая наноэлектроника	3aO	144	51	34		17	93	-	4							+-	_		ŀ	3aO	144	51	34		17	93	\rightarrow	4		27	7
1	7 Б:	1.В.ДВ.07.01	Основы технологии электронной компонентной базы											3aO KP	108	48	12	12 24	4 42	18	3		3aO KP	108	48	12	12	24	42	18	3		25	8
1	B 5	51.В.ДВ.07.02	Моделирование технологических процессов получения материалов электронной											3aO KP	108	48	12	12 24	4 42	18	3		3aO KP	108	48	12	12	24	42	18	3		27	8
H	+		Техники Математические модели технологических																			ŀ												
1	9 5	51.В.ДВ.07.03	процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики											3aO KP	108	48	12	12 24	42	18	3		3aO KP	108	48	12	12	24	42	18	3		27	8
2	0 Б	1.В.ДВ.08.01	Вакуумная и плазменная электроника											3aO	144	48	24	12 12	2 96		4	İ	3aO	144	48	24	12	12	96		4		25	8
2	1 5	51.В.ДВ.08.02	Квантоворазмерные структуры в наноэлектронике											3aO	144	48	24	12 12	96		4		3aO	144	48	24	12	12	96		4		25	8
2	2 5	51.В.ДВ.08.03	Технология производства ферритовых											3aO	144	48	24	12 12	2 96		4	İ	3aO	144	48	24	12	12	96		4		27	8
2	3 5	51.В.ДВ.08.04	материалов и радиокерамики Процессы вакуумной и плазменной											3aO	144	48	24	12 12	2 96		4	ŀ	3aO	144	48	24	12	12	96		4		27	8
	+		электроники Приборы квантовой и оптической						-	-								_	+			ŀ												
2	+	1.В.ДВ.09.01	электроники						_	+	_			Эк	144	60	24	12 24	+		4	ŀ	Эк	144	60	24	12	24	48	36	4		25	8
2	5 <i>E</i>	51.В.ДВ.09.02	Светоизлучающие полупроводниковые приборы											Эк	144	60	24	12 24	4 48	36	4		Эк	144	60	24	12	24	48	36	4		25	8
		51.В.ДВ.09.03	Магнитные измерения											Эк	144	60	24	12 24		36	4	ļ	Эк	144	60	24	12	24	48	36	4		27	8
2	7 5	51.В.ДВ.09.04	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики											Эк	144	60	24	12 24	4 48	36	4	Į	Эк	144	60	24	12	24	48	36	4		27	8
2	В Б	1.В.ДВ.10.01	Основы радиационной стойкости изделий электронной техники											3aO	144	48	24	24	4 96		4		3aO	144	48	24		24	96		4		25	8
2	9 5	51.В.ДВ.10.02	Элементы и устройства магнитоэлектроники											3aO	144	48	12	12 24	4 96		4	İ	3aO	144	48	12	12	24	96		4		27	8
3	0 6	51.В.ДВ.10.03	Физика взаимодействия частиц и излучений					\vdash		+	\dashv			3aO	144	48	12	12 24	4 96		4	ŀ	3aO	144	48	12	12	24	96	\neg	4		27	8
-	+	52.В.ДВ.04.01(H)	с веществом Научно-исследовательская работа	3aO	108	_	_	\vdash	+	108	\dashv	3		3aO	108	-"	-		108		3	ł	3aO(2)	216		-		<u> </u>	216	\rightarrow	6		25	678
_	_	52.В.ДВ.04.02(H)	Научно-исследовательская работа	3aO	108		L			108		3		3aO	108				108		3	ŀ	3aO(2)	216					216		6		27	678
3	3 Ф	тд.01	Оформление результатов научной деятельности	3a	72	8			8	64	П	2											За	72	8			8	64		2			7
3	4 ф	тд.02	Нормы и правила оформления ВКР											3a	72	8		8	64		2		За	72	8			8	64		2			8
Φ	OPM	иы контроля					Эк((3) 3a 3	aO(5) KI	Р							Эк 3	3a 3aO(4)) KP								Эк	(4) 3a(2	2) 3aO(9	9) KP(2)				
П	PAK	тики	(План)												108				108		3	2		108					108		3	2		
	Б	2.В.ДВ.03.01(Пд)	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы											3a	108				108		3	2	3a	108					108		3	2	25	8
	Б	52.В.ДВ.03.02(Пд)	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы											3a	108				108		3	2	3a	108					108	\Box	3	2	27	8
Г	СА	ДАРСТВЕННАЯ	ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИ (План)												324				324		9	6		324					324		9	6		
	T	3.ДВ.01.01	Подготовка к процедуре защиты и защита												324				324		9	6		324					324		9	6	25	8
\vdash	+	53.ДВ.01.02	выпускной квалификационной работы Подготовка к процедуре защиты и защита					\vdash	-	+	\dashv				324		\vdash		324	_	9	6		324					324	-	9	6	27	8
F	_		выпускной квалификационной работы												324				324		9			324					324		9		2/	
K	ΑНИ	ІКУЛЫ											2	<u> </u>								8										10		